

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.
英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2577)

自願公告
英諾賽科為800 VDC電源架構提供
全GaN電源解決方案，賦能新一代AI Factories

本公告由英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司（「本公司」或「英諾賽科」）自願作出，旨在使本公司股東及潛在投資者了解本公司最新業務發展情況。

NVIDIA將支持800 VDC電源架構。800 VDC機架電源架構為人工智能數據中心帶來突破性進展，可實現更高效率、更高功率密度，同時降低能耗需求並減少二氧化碳排放。如同電動汽車行業從400V向800V的升級，機架電壓從48V提升到800V可使電流降低16倍，從而大幅減少 I^2R 損耗並最大限度降低對銅材的需求。英諾賽科正與NVIDIA合作，攜手支持800 VDC電源架構，為新一代GPU路線圖的擴展提供保障。

基於48V電壓的傳統人工智能系統正面臨嚴峻的挑戰——效率低下、銅耗過高，超過45%的總功耗耗費在散熱上。未來的人工智能集群（如搭載超過500塊GPU的機架）若沿用舊式PSU電源設計，將無空間容納計算單元。800 VDC架構正是支持系統從千瓦級躍升至兆瓦級的解決方案。

除了向800V機架電源過渡外，該架構還要求在800V到1V的電壓轉換中實現超高功率密度和超高效率。只有氮化鎵功率器件(GaN)能夠同時滿足這些嚴苛要求。

為滿足800 VDC的功率密度要求，電源開關頻率必須提升至近1MHz，以縮小磁性元件和電容器的尺寸。現有機架式電源的典型開關頻率最高可達300kHz，如果提升至1MHz可使磁芯尺寸縮減約50%。

英諾賽科第三代氮化鎵技術具備決定性優勢：

- 在800V輸入側，英諾賽科氮化鎵(GaN)與碳化硅(SiC)相比在每個開關半週期內可降低80%的驅動損耗和50%的開關損耗，從而實現整體功耗降低10%。
- 在54V輸出端，僅需16顆英諾賽科氮化鎵器件即可實現與32顆硅MOSFET相同的導通損耗，不僅將功率密度提升一倍，還使驅動損耗降低90%。
- 與現有機架架構中的硅MOSFET相比，800 VDC的低壓電源轉換階段採用氮化鎵材料可將開關損耗降低70%，並在相同體積內實現功率輸出提升40%，大幅提升功率密度。
- 基於氮化鎵的低壓功率級可擴展以支持更高功率的GPU型號，其動態響應得到提升，同時降低了電路板上的電容成本。



作為業內唯一的全棧氮化鎵供應商及領先的氮化鎵IDM企業，英諾賽科是唯一實現1200V至15V氮化鎵量產的公司，可提供從800V到1V的全鏈路解決方案。這使英諾賽科成為唯一有能力為所有轉換階段提供全GaN功率解決方案的供應商，從容應對未來架構為滿足更高功率需求的演變。

英諾賽科氮化鎵在可靠性方面同樣處於領先地位。其第三代器件已通過嚴苛的加速應力測試，包括加長的2000小時動態HTOL測試、高溫(175°C)驗證及大樣本失效驗證。自主開發的在線動態電阻監測與長期板級應力測試確保其數據中心級產品的高性能工作壽命超過20年。

作為全球領先的氮化鎵IDM企業，英諾賽科第三代氮化鎵器件具備卓越的快速開關特性、高效率、高功率密度及優異可靠性。通過整合800 VDC電源架構與英諾賽科氮化鎵技術，人工智能數據中心將實現從千瓦級機架到兆瓦級機架的飛躍，開啟更高效、更高性能、更可靠且更環保的人工智能加速計算新時代。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司
董事長兼執行董事
Weiwei Luo博士

中國，2025年10月14日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Weiwei Luo博士、Jay Hyung Son先生、吳金剛博士及鍾山先生；非執行董事汪燦博士、張彥紅女士及崔米子女士；及獨立非執行董事黃顯榮先生，榮譽勳章，太平紳士、易繼明博士、楊士寧博士及陳正豪博士。